

3.1.12.1

Um transistor NPN é formado de

- a) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo P colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo N
- b) um emissor, uma base mas sem colector
- c) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo N colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo P
- d) um material emissor de electrões e de protões

Nota: ver "Nota" da pergunta nº. 3.1.3.2

3.1.12.2

Um transistor PNP é formado de

- a) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo P colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo N.....
- b) um emissor, uma base mas sem colector
- c) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo N colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo P
- d) um material emissor de electrões e de protões

Nota: ver "Nota" da pergunta nº. 3.1.3.2

3.1.13.1

A polarização dos transistores de base à massa é aplicada do seguinte modo:

- a) base-emissor e base-colector, ambas directas
- b) base-emissor, directa e base-colector, inversa
- c) base-emissor e base-colector, ambas inversas
- d) base-emissor e base-colector, directa